

Rys. 1-1048. SM104

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanał typu N normalnie załączony) o dużej impedancji wejściowej w obudowie plastikowej, płytka krzemowa połączona wewnątrz obudowy ze źródłem, ciężar około 0,3 G

Zastosowanie: do ogólnego stosowania

Typy podobne KF520 (Tesla), 3SK21 (Hit)

Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

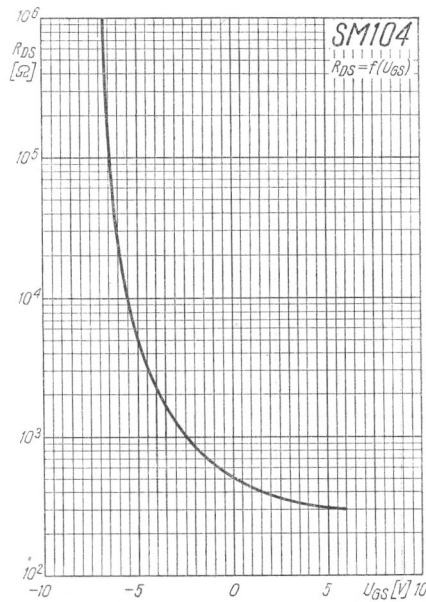
	min	typ	max		
$U_{(BR)DSV}$	20			V	przy $-U_{GS} = 12$ V, $I_D = 10$ $\mu$ A
$-U_T$		5,5	8	V	przy $U_{DS} = 8$ V, $I_D = 10$ $\mu$ A
$-I_D$	1,5	4,5	6,5	mA	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$
$R_{we}$	10 <sup>12</sup>	10 <sup>14</sup>		$\Omega$	przy $-U_{GSS} = 10$ V
$C_{11s}$		5,2	6	pF	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$
$\gamma_{21s}$	1	1,3		mS	przy $U_{DS} = 8$ V, $U_{GS} = 0$ , $f = 1$ kHz

Wartości graniczne

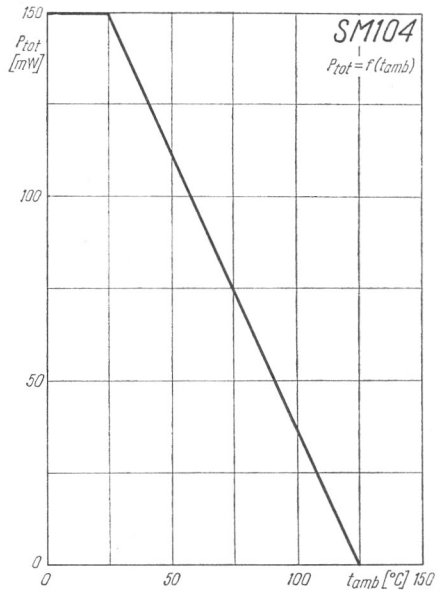
$U_{DSV}$ max	20	V	$P_{tot}$ max	150 <sup>2)</sup>	mW
$U_{GS}$ max	-15 ÷ +5	V	$t_k$ max	+125	°C
$U_{DG}$ max	32	V	$t_{amb}$	-40 ÷ +125	°C
$I_D$ max	15	mA	$R_{th j-a}$	0,6	°C/mW

<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$  ( $-5^\circ\text{C}$ )

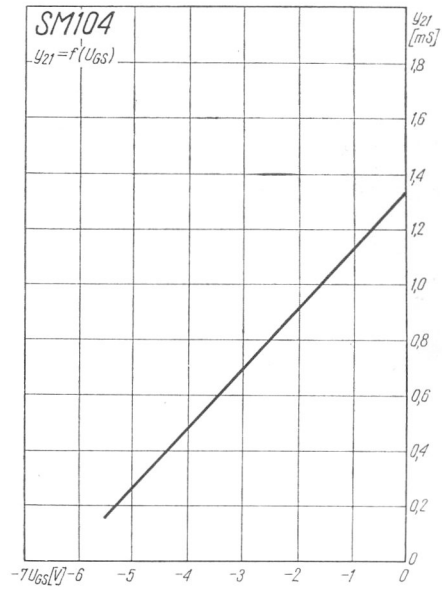
<sup>2)</sup>  $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$



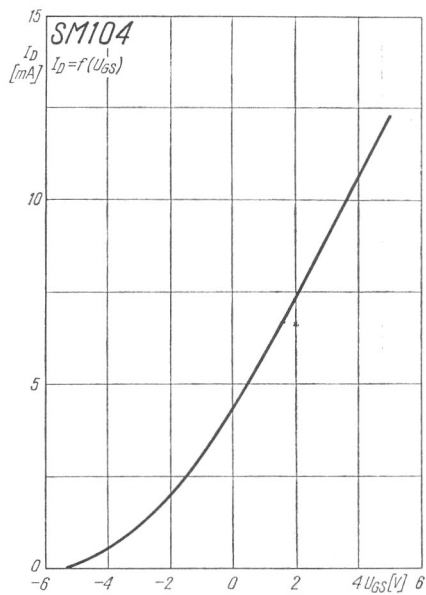
Rys. 1-1049. Zależność rezystancji  $R_{DS}$  od napięcia bramki



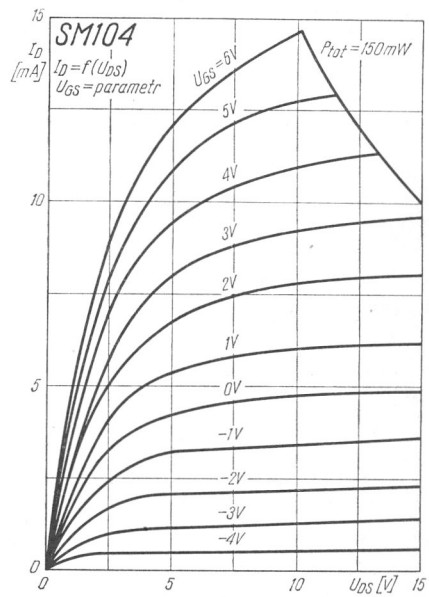
Rys. 1-1050. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1051. Zależność parametru  $y_{21}$  od napięcia bramki



Rys. 1-1052. Charakterystyka przejściowa tranzystora



Rys. 1-1053. Charakterystyki wyjściowe